



111 年度工研院材料與化工研究所 電子元件及其材料相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 25 案 71 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

- （一）固態電容 15 案 44 件；
- （二）電解電容 3 案 9 件；
- （三）超級電容 3 案 6 件；
- （四）內埋式電容 2 案 5 件；
- （五）被動保護元件 1 案 6 件；
- （六）紅外線阻隔材料 1 案 1 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

- （一）公開說明會將於民國（下同）111 年 10 月 11 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。
- （二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 10 月 7 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「111 年度工研院材料與化工研究所電子元件及其材料相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 10 月 7 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- （三）自本讓與案公告日起至截標日 111 年 10 月 20 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

- （一）本讓與案採通訊或親送方式投標。



投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件 (如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。

(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「111 年度工研院材料與化工研究所電子元件及其材料相關專利讓與案投標」，於截標日 111 年 10 月 20 日 17 時整 (含) 前 (以送達收據為憑) 掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 黃小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介 (20%)
2. 公司財務狀況 (20%)
3. 公司營運／研發能力 (20%)
4. 「讓與標的」運用規劃 (30%)
5. 國內產業效益 (10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。

(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

(一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。

(二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。

(三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標時未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果(包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果)轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

- (一) 分為初審(開標日為 111 年 10 月 21 日)及複審(決標日為 111 年 11 月 3 日)，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書進行書面審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔及書面文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商底價單，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 決標時將請律師到場監標。
- (八) 決標後將個別通知投標廠商決標結果(不公告得標廠商)。

- (九) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- (二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。
- (三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。
- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：
1. 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 2. 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 3. 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 4. 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

(十二) 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

1. 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
2. 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
3. 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

(十三) 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

(十四) 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

(十五) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份



累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

（十七）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 黃小姐。

電話：(03) 591-4364，傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：yt.huang@itri.org.tw。

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。



附件：專利清單

(一) 固態電容：15 案 44 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
1	1	P05910047	P05910047CN	制造固態電解電容器的配方及其制作方法	中國大陸	獲證	03102636.2	CN100372034	20080227	20230213	V
	2	P05910047	P05910047TW	製造固態電解電容器之配方及其製程	中華民國	獲證	91136357	583226	20040411	20221216	V
	3	P05910047	P05910047US	製造固態電解電容器之配方及其製程	美國	獲證	10/712,045	7208104	20070424	20250131	V
2	4	P05910074	P05910074TW	固態電解電容器以及其製造方法	中華民國	獲證	92105266	I223294	20041101	20230310	V
	5	P05910074	P05910074US	固態電解電容器以及其製造方法	美國	獲證	10/765,941	6862170	20050301	20240128	V
3	6	P05920061	P05920061CN	固態電解電容器、其製造方法及其所使用的耦合劑	中國大陸	獲證	200510051364.3	CN1832073	20100428	20250307	V
	7	P05920061	P05920061TW	固態電解電容器、其製造方法、及其所使用的耦合劑	中華民國	獲證	92137052	I239542	20050911	20231225	V
	8	P05920061	P05920061US	固態電解電容器、其製造方法、及其所使用的耦合劑	美國	獲證	10/818,025	6920036	20050719	20240404	V
	9	P05920061	P05920061USD2	固態電解電容器、其製造方法、及其所使用的耦合劑	美國	獲證	11/559,935	7374586	20080520	20240530	V
4	10	P54000018	P54000018CN	去耦合元件及其製造方法	中國大陸	獲證	201110447553.8	CN103107021	20160413	20311222	V
	11	P54000018	P54000018JP	去耦合元件及其製造方法	日本	獲證	2012-189169	5535286	20140509	20320828	V
	12	P54000018	P54000018TW	去耦合元件及其製造方法	中華民國	獲證	100141045	I511172	20151201	20311109	V
	13	P54000018	P54000018US	去耦合元件及其製造方法	美國	獲證	13/350,813	8922976	20141230	20321128	V
5	14	P54000129	P54000129CN	氧化劑混合物、電解質混合物、及其製成的電解電容器	中國大陸	獲證	201210414334.4	CN103578770	20160824	20321024	V
	15	P54000129	P54000129TW	電解質混合物、及用此電解質混合物之電解電容器、及其合成共軛高分子用之氧	中華民國	獲證	101127060	I591670	20170711	20320725	V



案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
				化劑混合物							
	16	P54000129	P54000129US	電解質混合物、及用此電解質混合物之電解電容器、及其合成共軛高分子用之氧化劑混合物	美國	獲證	13/951,470	9355785	20160531	20331229	V
6	17	P54000130	P54000130TWC1	電解電容器用電解質混合物、用以合成導電高分子之組成物及使用此混合物之導電高分子固態電解電容器	中華民國	獲證	102122586	I483275	20150501	20330624	V
	18	P54000130	P54000130USC1	電解電容器用電解質混合物、用以合成導電高分子之組成物及使用此混合物之導電高分子固態電解電容器	美國	獲證	13/951,469	9362057	20160607	20330818	V
7	19	P54010005	P54010005CN	去耦合元件及其製造方法	中國大陸	獲證	201210413243.9	CN103680991	20170412	20321024	V
	20	P54010005	P54010005TW	去耦合元件及其製造方法	中華民國	獲證	101133539	I443698	20140701	20320912	V
	21	P54010005	P54010005US	去耦合元件及其製造方法	美國	獲證	13/743,327	9214284	20151215	20340213	V
8	22	P54040055	P54040055CN	導電材料與電容器	中國大陸	獲證	201511004978.6	CN106920694	20190405	20351228	
	23	P54040055	P54040055TW	導電組成與電容器	中華民國	獲證	104143523	I597313	20170901	20351223	
	24	P54040055	P54040055US	導電組成與電容器	美國	獲證	15/350,850	10262808	20190416	20370822	
9	25	P54040056	P54040056CN C1	電容結構	中國大陸	獲證	201611126816.4	CN107017087	20190514	20361208	
	26	P54040056	P54040056TWC1	電容結構	中華民國	獲證	105137583	I602206	20171011	20361116	
	27	P54040056	P54040056US	電容結構	美國	獲證	15/388,465	10020119	20180710	20361221	
10	28	P54950084	P54950084CN	電解電容器的電極	中國大陸	獲證	200710004357.7	CN101231911	20110928	20270123	
	29	P54950084	P54950084TW	電解電容器之電極	中華民國	獲證	95149398	I398888	20130611	20261227	
11	30	P54950113	P54950113CN	固態電解電容器及其導線架	中國大陸	獲證	200710000696.8	CN101226828	20100616	20270116	V
	31	P54950113	P54950113TW	固態電解電容器及其導線架	中華民國	獲證	95149992	I320191	20100201	20261228	V
	32	P54950113	P54950113US	固態電解電容器及其導線架	美國	獲證	11/766,802	7447000	20081104	20270621	V



案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
12	33	P54970034	P54970034CN	複合陰極箔及包含此陰極箔之固態電解電容器	中國大陸	獲證	200810185732.7	CN101752091	20120314	20281207	
	34	P54970034	P54970034TW	複合陰極箔及包含此陰極箔之固態電解電容器	中華民國	獲證	97145674	I407468	20130901	20281125	
	35	P54970034	P54970034US	複合陰極箔及包含此陰極箔之固態電解電容器	美國	獲證	12/344,426	8644006	20140204	20300430	
13	36	P54980059	P54980059TW	去耦合元件	中華民國	獲證	98145811	I385684	20130211	20291229	V
	37	P54980059	P54980059US	去耦合元件	美國	獲證	12/776,442	8289679	20121016	20310513	V
14	38	P54980060	P54980060TW	複合間隔物、固態電解電容器及其製作方法	中華民國	獲證	98136900	I475584	20150301	20291029	V
15	39	P54990056	P54990056CN	去耦合組件	中國大陸	獲證	201010623837.3	CN102543445	20141231	20301230	V
	40	P54990056	P54990056CN D1	去耦合組件	中國大陸	獲證	201410314386.3	CN104103427	20180206	20301230	V
	41	P54990056	P54990056JP	去耦合元件	日本	獲證	2011-187710	5303616	20130628	20310829	V
	42	P54990056	P54990056TW	去耦合元件	中華民國	獲證	99146364	I492254	20150711	20301227	V
	43	P54990056	P54990056US	去耦合元件	美國	獲證	13/053,195	8773844	20140708	20311027	V
	44	P54990056	P54990056US C1	去耦合元件	美國	獲證	14/265,365	9058933	20150616	20310320	V

(二) 電解電容：3 案 9 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
16	45	P05930064	P05930064CN	苯胺聚合延遲劑	中國大陸	獲證	200510067944.1	CN100413910	20080827	20250427	
	46	P05930064	P05930064TW	苯胺聚合延遲劑	中華民國	獲證	94106973	I279405	20070421	20250307	
	47	P05930064	P05930064US	苯胺聚合延遲劑	美國	獲證	11/368,637	7442328	20081028	20260306	
17	48	P05940012	P05940012CN	用於氧化聚合法合成導電性高分子的氧化劑	中國大陸	獲證	200510126003.0	CN1974643	20110420	20251127	
	49	P05940012	P05940012TW	用於氧化聚合法合成導電性高分子之氧化劑	中華民國	獲證	94137859	I306461	20090221	20251027	
	50	P05940012	P05940012US C1	用於氧化聚合法合成導電性高分子之氧化劑	美國	獲證	12/588,323	9156923	20151013	20271121	



案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
18	51	P54960064	P54960064CN	參考電極	中國大陸	獲證	200810007091.6	CN101498680	20130320	20280201	
	52	P54960064	P54960064TW	參考電極	中華民國	獲證	96150818	I372862	20120921	20271227	
	53	P54960064	P54960064US	參考電極	美國	獲證	12/186,511	8187435	20120529	20301024	

(三) 超級電容：3 案 6 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
19	54	P27000053	P27000053CN C1	電容器及其製造方法	中國大陸	獲證	201210239745.4	CN103165294	20151216	20320709	
	55	P27000053	P27000053TW C1	電容器及其製造方法	中華民國	獲證	101120686	I466153	20141221	20320607	
	56	P27000053	P27000053US	電容器及其製造方法	美國	獲證	13/615,650	8848339	20140930	20330211	
20	57	P27010009	P27010009TW	多孔性碳材料及其製作方法、以及超級電容器	中華民國	獲證	101140050	I472483	20150211	20321029	
	58	P27010009	P27010009US	多孔性碳材料及其製作方法、以及超級電容器	美國	獲證	13/728,700	9425000	20160823	20340919	
21	59	P27010029	P27010029TW	多孔性碳材料材料的製作方法	中華民國	獲證	101144659	I518718	20160121	20321128	

(四) 內埋式電容：2 案 5 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
22	60	P54960094	P54960094CN C1	複合型電容	中國大陸	獲證	201210188751.1	CN102693975	20150916	20271227	
	61	P54960094	P54960094TW	複合型電容	中華民國	獲證	96149241	I345797	20110721	20271220	
	62	P54960094	P54960094US	複合型電容	美國	獲證	12/050,188	7561410	20090714	20280317	
23	63	P54960095	P54960095TW	貫通孔電容器及其製造方法	中華民國	獲證	96149239	I373118	20120921	20271220	
	64	P54960095	P54960095US	貫通孔電容器及其製造方法	美國	獲證	12/046,422	7894178	20110222	20281125	

(五) 被動保護元件：1 案 6 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
24	65	P54000024	P54000024CN	保護元件及應用此保護元件的保護裝置	中國大陸	獲證	201110261707.4	CN102956413	20160406	20310905	
	66	P54000024	P54000024CN C1	保護元件及應用此保護元件的保護裝置	中國大陸	獲證	201210261594.2	CN102956414	20150826	20320725	



案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
	67	P54000024	P54000024DE	保護元件及應用此保護元件之保護裝置	德國	獲證	102012016158.1	102012016158	20210128	20320813	
	68	P54000024	P54000024JP	保護元件及應用此保護元件之保護裝置	日本	獲證	2012-181154	5523521	20140418	20320816	
	69	P54000024	P54000024TWC1	保護元件及應用此保護元件之保護裝置	中華民國	獲證	101123841	I488208	20150611	20320702	
	70	P54000024	P54000024US	保護元件及應用此保護元件之保護裝置	美國	獲證	13/587,005	9019678	20150428	20330521	

(六) 紅外線阻隔材料：1 案 1 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
25	71	P54020015	P54020015TW	紅外光阻隔之金屬氧化物多層膜結構	中華民國	獲證	102130002	I487625	20150611	20330821	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。